Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0400U002934

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 16-11-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Максимова Тетяна Іванівна

2. Maksymova Tetyana Ivanivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.01

Назва наукової спеціальності: Фізика приладів, елементів і систем

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 26-10-2000

Спеціальність за освітою: 7.080101

Місце роботи здобувача: Криворіжський державний педагогічний університет

Код за ЄДРПОУ: 02125177

Місцезнаходження: 53086 м.Кривий Ріг,пр-т Гагаріна, 54

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 41.052.06

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Криворіжський державний педагогічний університет

Код за ЄДРПОУ: 02125177

Місцезнаходження: 53086 м.Кривий Ріг,пр-т Гагаріна, 54

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:

1. Модифікація структурних характеристик поверхні (001) кремнію в мікроелектронній технології

2. Modification of structural characteristics of Si (001) surface in microelectronic technology

Реферат/анотація:

1. Методом молекулярної динаміки досліджено вплив температури формування поверхні і низькоенергетичної радіаційної дії на структурні характеристики поверхні (001) Si. Одержано нові дані щодо впливу температури формування поверхні на особливості релаксації поверхневих шарів. При високих температурах релаксації виникає квазірозупорядкована поверхнева фаза, що характеризується дефектними ділянками і обірваними зв'язками, які зумовлюють множинні поверхневі реакції, а також особливості формування границі кремній-діелектрик. Показана доцільність використання допорогової радіаційної обробки для стабілізації і відновлення поверхні (001) Si, одержання однорідних по структурі приповерхневих шарів. Виявлені оптимальні умови радіаційного опромінення

2. The processes of the temperature surface formation and low-energy radiation effects in Si (001) surface layers were investigated by computer simulation method. The method of molecular dynamics with empirical potentials was used. The microstructure of relaxed Si surface layers was studied. It was established the formation a quasi disordered phase with different structural peculiarities at high temperatures in comparison with volume structure.

The main features in this phase are abnormal atomic polygons, dangling bonds and an arising of dimers in four surface layers. The subthreshold radiation in order to surface defect layers recover was explored

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Соловйов Володимир Миколайович
2. Соловйов Володимир Миколайович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Новіков Віталій Володимирович
2. Новіков Віталій Володимирович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гохман Олександр Рафаїлович
2. Гохман Олександр Рафаїлович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Вікулін Іван Михайлович
2. Вікулін Іван Михайлович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Русов Віталій Данилович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Русов Віталій Данилович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.